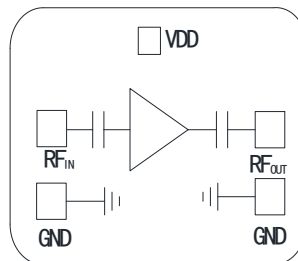


特点:

- 频率范围: 0.6~1.6GHz
- 增益: 28.5dB typ.
- 噪声系数: 0.35dB typ.
- 输出 1dB 压缩点: 17.5dBm typ.
- 单电源工作: +5V@65mA
- 芯片尺寸: 1.4mm×1.31mm×0.1mm

功能框图:



产品简介:

YDC1132 是一款采用 GaAs pHEMT 工艺设计制造的低噪声放大器芯片。该芯片采用了片上金属化通孔工艺保证良好接地。芯片背面进行了金属化处理, 适用于导电胶粘接或共晶烧结工艺。

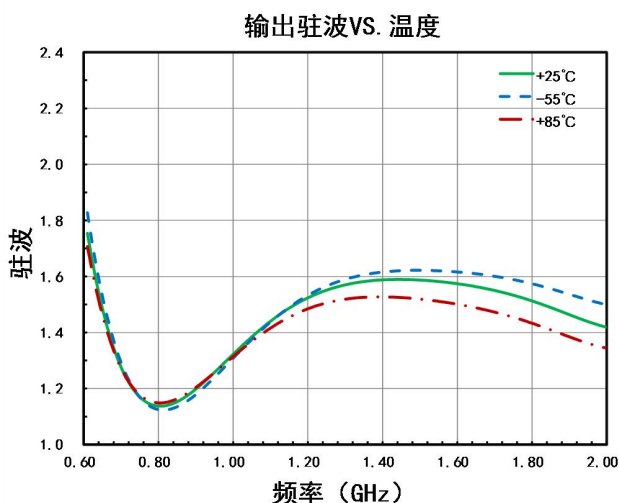
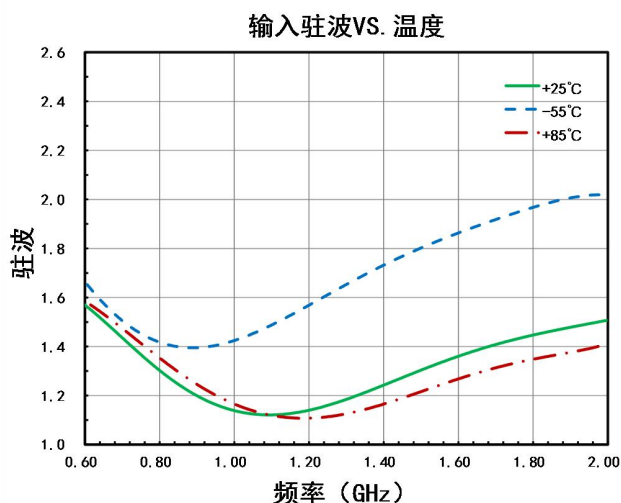
性能参数: (50Ω系统, $T_A=+25^{\circ}\text{C}$, $V_{dd}=+5\text{V}$, $I_{dd}=65\text{mA}$)

参数名称	符号	参数值			单位
		MIN	TYP	MAX	
频率范围	Frequency	0.6	-	1.6	GHz
增益	Gain	-	28.5	-	dB
增益平坦度	ΔG	-	± 0.5	-	dB
输入驻波比	VSWR _I	-	1.4	-	-
输出驻波比	VSWR _O	-	1.5	-	-
噪声系数	NF	-	0.35	-	dB
反向隔离度	IR	-	45	-	dB
输出 P-1dB	OP _{-1dB}	-	17.5	-	dBm
输出 IP ₃ *	OIP ₃	-	29	-	dBm
电源电压	V_{dd}	-	+5	-	V
工作电流	I_{dd}	-	65	-	mA

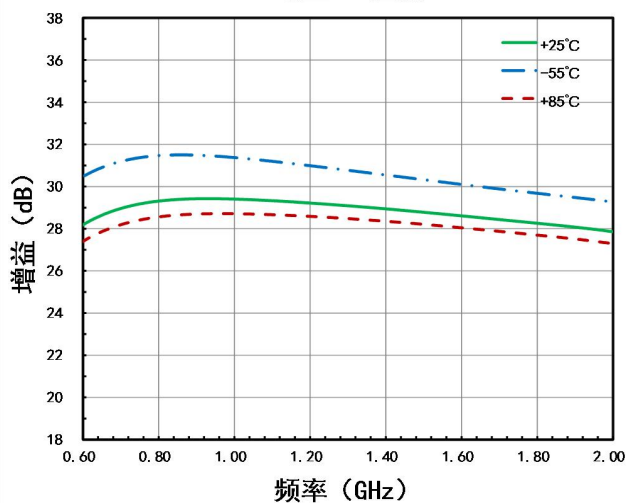
*: OIP₃ 测试条件: 双音信号间隔 1MHz, Pout=+0dBm/tone。

** : 芯片均经过在片 100% 直流与 RF 测试。

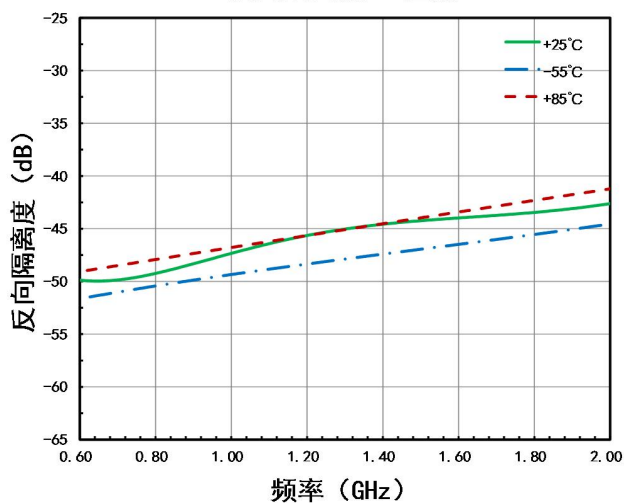
典型测试曲线: (50Ω系统, $V_{dd}=+5\text{V}$, $I_{dd}=64\text{mA}$)



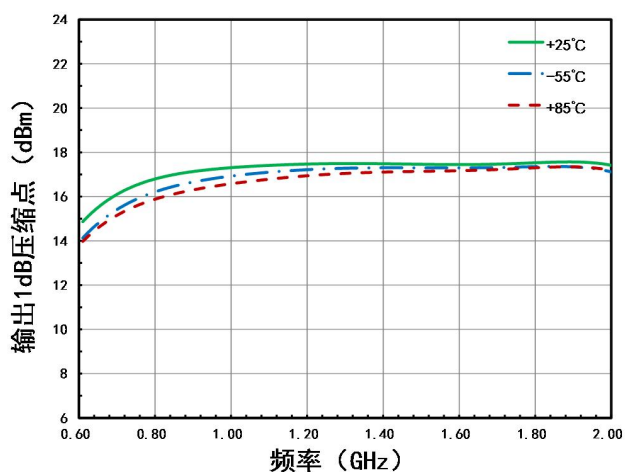
增益VS. 温度



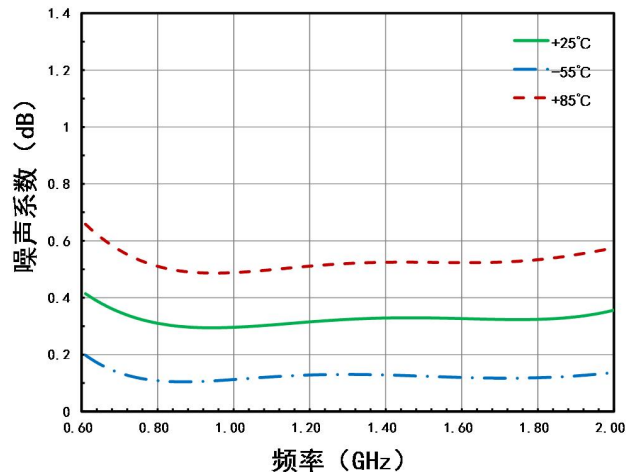
反向隔离度VS. 温度



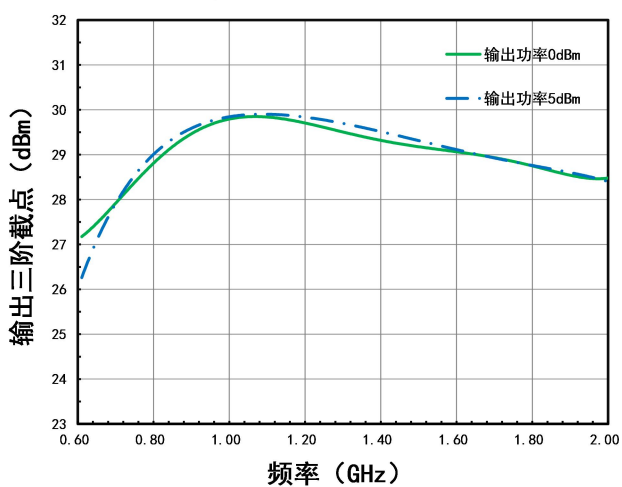
输出1dB压缩点VS. 温度



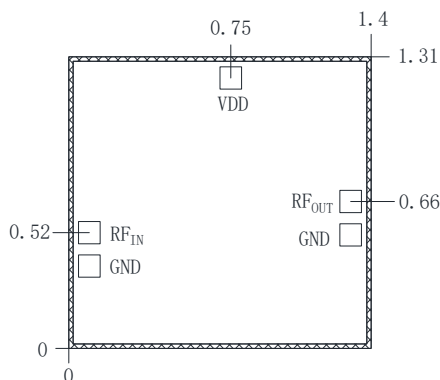
噪声系数VS. 温度



输出三阶截点VS. 频率(+25°C)



外形尺寸图:



注：1.单位：mm；

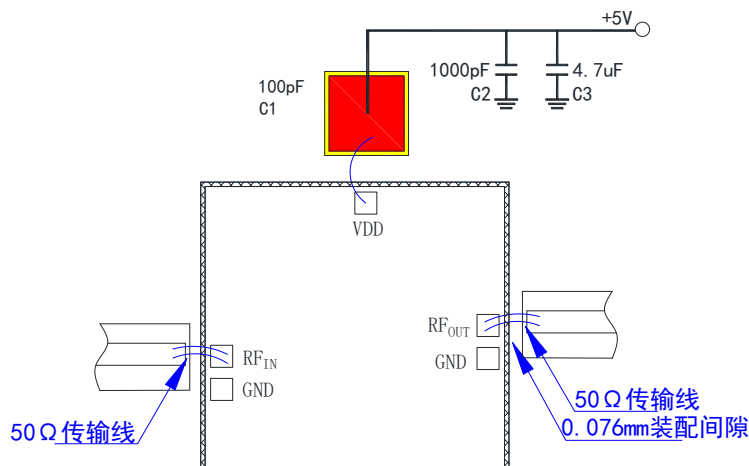
2.芯片背面镀金，背面接地；

3.外形尺寸公差： $\pm 0.05\text{mm}$ ；

4.键合压点镀金，压点尺寸： $0.1 \times 0.1\text{mm}$ 。



推荐装配图:



注：射频端口应尽量靠近微带线以缩短键合金丝尺寸，典型的装配间隙是 $0.076 \sim 0.152\text{mm}$ ，使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合，建议金丝长度 $250 \sim 400\mu\text{m}$ 。

产品使用注意事项:

1. 本芯片产品需要在干燥、氮气环境中存储，在超净环境装配使用。
2. 裸芯片使用的砷化镓材料较脆，芯片表面容易受损，不能用于干或湿化学方法清洁芯片表面，使用时须小心。
3. 芯片粘结装配时，需考虑热膨胀应力对芯片的影响，芯片建议烧结或粘结在热膨胀系数相近的载体上，如可伐、钨铜或钼铜垫片上，避免热膨胀应力匹配不当导致芯片开裂。
4. 芯片使用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 $+300^\circ\text{C}$ ，时间不能超过20秒），使之充分接地。
5. 芯片射频端口使用 $25\mu\text{m}$ 双金丝键合，建议金丝长度 $0.25 \sim 0.40\text{mm}$ （ $10 \sim 16\text{ mils}$ ）。
6. 在存储和使用过程中注意防静电，烧结、键合台接地良好。

引脚定义:

符号	描述
RF _{IN}	射频输入，内部有隔直
RF _{OUT}	射频输出，内部有隔直
VDD	电源端口，+5V 供电
GND/芯片背面	接地，芯片底部需接地良好

极限参数表:

参数名称	极限值
输入射频功率， 50Ω	+20dBm
电源电压	+8V
装配温度	+300 $^\circ\text{C}$ ，20s
工作温度	-55 $^\circ\text{C}$ ~+85 $^\circ\text{C}$
贮存温度	-55 $^\circ\text{C}$ ~+150 $^\circ\text{C}$
静电放电敏感度等级	1A

超过以上任何一项极限参数，可能造成器件永久损坏。